

# 2SB755

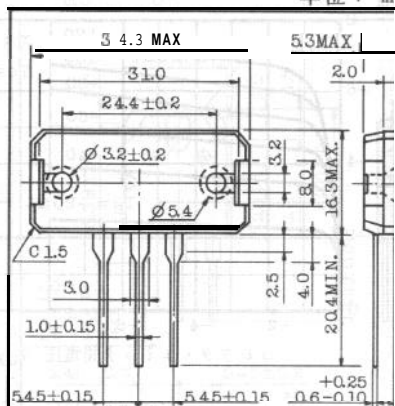
シリコンPNP三重拡散形トランジスタ

○ 電力増幅用

特長

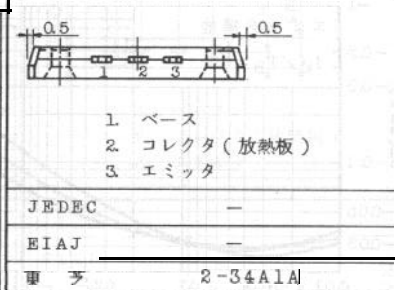
- 高耐圧です。:  $V_{CE0} = -150V$  (最小)
- トランジション周波数が高い。:  $f_T = 20MHz$  (標準)
- 2SD845 とコンプリメンタリになります。
- 80W ハイファイ オーディオアンプに最適です。

単位: mm



最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	-150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	-150	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-12	A
ベース電流	$I_B$	-12	A
コレクタ損失 ( $T_c = 25^\circ C$ )	$P_C$	120	W
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ 150	$^\circ C$



電気的特性 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB} = -150V, I_E = 0$	-	-	-50	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EB0}$	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	-	-	-50	$\mu A$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C = -0.1A, I_B = 0$	-150	-	-	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E = -10mA, I_C = 0$	-5	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE}$ (注)	$V_{CE} = -5V, I_C = -1A$	55	-	160	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -5A, I_B = -0.5A$	-	-	-2.0	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -5A$	-	-	-1.5	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -10V, I_C = -1A$	-	20	-	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	-	450	-	pF

注:  $h_{FE}$  分類 R: 55 ~ 110, Q: 80 ~ 160

